

RFMD News Release

Company Contact:

RF Micro Devices Inc.
Irma Swain, Director, Communications Manager
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
Tel: +1 336-931-6653
iswain@rfmd.com



rfmd.com

RFMD®, GaN 파운드리 서비스 사업 발표

화합물 반도체 기술 및 제조 분야에서
RFMD의 산업 선도적 지위를 활용한 파운드리 서비스 사업부 설립
고신뢰성, 고성능의 가격 경쟁력이 높은 GaN 기술 실현

보스톤 –2009년 6월 10일, IEEE MTT-S -- 세계적인 고성능 반도체 부품 전문 개발업체인 RFMD(RF Micro Devices, Inc., NASDAQ: RFMD)는 고신뢰성, 고성능 및 가격 경쟁력이 높은 GaN 반도체 기술을 다양한 RF 전력 시장에 공급하기 위해 GaN(gallium nitride) 파운드리 사업부를 설립했다고 발표했다. RFMD GaN 파운드리 서비스 사업부는 GaAs(gallium arsenide) 제조 역량 및 주기에서 이 회사의 업계 선도적 지위뿐 만 아니라 새로운 고객 서비스 범위를 활용해, 더욱 단축된 시장 출시 시점을 주도하고 초기 웨이퍼 주문 및 최종 선적 간의 시간을 최소화할 시킬 방침이다. RFMD는 GaAs 화합물 반도체의 업계 선도적인 제조업체이다. RFMD의 GaN 제조는 GaAs 제조와 상호호환성이 있으며 RFMD가 확보한 업계 선도적인 웨이퍼 가공 케파의 규모와 전문 기술의 이점을 직접 누리게 된다.

RFMD의 멀티마켓 제품 그룹의 밥 반 부스키르크(Bob Van Buskirk) 사장은 “RFMD의 파운드리 서비스 사업부는 RFMD의 업계 선도적인 화합물 반도체 기술 및 생산 시설에 대해 GaN 파운드리 고객 접근을 제공하며, 신뢰성, 균일성, 주기, 품질을 포함해 RFMD의 스케일 제조의 이점을 제공한다. RFMD GaN은 우수한 선형성, 대역폭, RF 전력 밀도의 결과로서 RF 전력 부품 산업을 변화시킬 수 있는 혁신적인 기술이다. 또한, RFMD GaN은 기존의 가능성이 있는 기술보다 더욱 효율성을 실현하는 ‘그린’ 기술이며, 이에 따라 더 적은 소비 전력을 요구해 유사한 전력 소비 레벨에서 비슷하거나 더욱 뛰어난 성능을 달성한다”라고 말했다.

RFMD의 GaN 파운드리 서비스는 산업에서 매우 차별화되어 있다. 그 이유는 RFMD가 업계에서 가장 규모가 큰 GaAs 가공 시설(팹)을 운영하고 있으며 고객에게 RF 부품에 기반한 수십억 개의 고신뢰성, 고품질 화합물 반도체를 제공하기 때문이다. 기존의 대용량 제조 자산을 활용함으로써, RFMD는 예상할 수 있는 업계 선도적인 신뢰성 및 균일성 향상로 파운드리 고객에게 GaN 기술을 제공할 수 있다. RFMD는 업계 선도적인 주기를 제시하며 자사의 웨이퍼 팹을 통한 GaN 주기는 일반적으로 경쟁사보다 30 -40% 더욱 신속한 것으로 평가된다”라고 말했다.

또한, 정확하게 제품 성능을 예측할 수 있는 RFMD의 반도체 공정 모델에 대한 심도 깊은 지식을 활용함으로써, RFMD의 파운드리 서비스 사업부는 고객의 스펙을 만족시키기 위해 필요한 프로토타입 동작 수를 감소시킴으로써 고객 개발 비용을 낮춰줄 수 있다. RFMD GaN에서 혜택을 받을 수 있는 고객 애플리케이션은 무선 인프라, CATV 라인 증폭기, 광대역 통신, 전력 증폭기, 다양한 방위 레이더 시스템을 포함해 상업용 및 방위용 전력 애플리케이션이 포함된다.

또한 RFMD의 파운드리 서비스 고객들은 파운드리 고객 예측 및 요건에 대해 현장에서 직접 체험한 지식을 겸비한 능숙한 파운드리 서비스 지원 팀의 지원을 받는다. RFMD의 파운드리 서비스 지원 팀은 파운드리 고객 및 파운드리 공급업체로서 50년 이상의 파운드리 서비스 경험을 쌓고 있다. 게다가, RFMD의 파운드리 서비스 지원 팀은 주문 초기 단계에서부터 고객 납기까지 전체 시간을 최소화할 수 있도록 일련의 서비스를 구축했다. 서비스는 초기 성공의 높은 이익을 가능하게 하는 시뮬레이션 모델과 대기 시간이 거의 없는 비즈니스 공정을 포함한다.

RFMD GaN는 경쟁사 기술보다 훨씬 더 높은 전력 밀도 및 항복 전압을 실현하는 차세대 화합물 반도체 기술이며 고성능 전력 디바이스에 이상적으로 적합하다. RFMD의 일반적인 동작 특성은 48 (또는 65)V의 동작 전압, 6 ~ 8 watts/mm의 전력 밀도, 11 GHz의 FT, 18 GHz의 F, 150°C T 채널 동작에서 10⁸ 시간 이상의 MTTF를 포함한다.

RFMD 회사소개

RFMD(NASDAQ GS: RFMD)는 세계적인 고성능 반도체 부품 설계 및 제조 전문업체이다. RFMD의 제품은 휴대폰 단말기, 무선 인프라, 무선랜(WLAN), CATV/광대역 및 항공우주/방위 시장에서의 전세계 이동성을 가능케 하며, 연결성을 강화하고 최신 최첨단 기능을 지원한다.

다양한 최첨단 반도체 기술과 우수한 RF 시스템 전문 기술력을 갖춘 RFMD는 세계 유수의 모바일 기기, CPE(customer premises equipment) 및 통신 장비 제조업체들에게 가장 많이 선호되고 있는 업체이다.

미국 노스캐롤라이나 그린스보로에 위치한 RFMD는 ISO 9001 및 ISO 14001 인증업체로, 전세계에 엔지니어링, 설계, 판매 및 서비스 관련 시설을 갖추고 있다. RFMD는 NASDAQ 시장에서 RFMD 기호로 거래되고 있다. 더 자세한 정보는 홈페이지 참조 www.rfmd.com.

참고 (면책규정)

본 보도자료는 1995년에 제정된 증권인사소송법 조항의 면책규정 정의 내에서 전망적 진술을 포함하고 있다. 이러한 전망적 진술에는 RFMD의 계획, 목적, 표현 및 의도에 대한 진술이 포함은 되어 있지만, 반드시 여기에 국한되는 것은 아니며, 과거 사실이 아니다. 일반적으로 '~일지 모르다', '~할 것이다', '~해야 한다', '~할 수 있다', '~기대하다', '~계획하다', '~예견하다', '~믿는다', '~추정하다', '~예측하다', '~잠재력 있는', '~계속하다'를 비롯해 이와 비슷한 표현들이 이와 같은 진술에 포함되며, 일부 전망적 진술은 다르게 표현되기도 한다. 여기에 포함된 전망적 진술은 경영진의 현 상황에 있어서의 판단이나 기대를 나타내는 것일 뿐이며, 사실적 결과, 사건, 성과는 이렇게 표현되거나 내포하고 있는 전망적 진술과는 실제로 다를 수도 있다. RFMD는 연방증권법에 의해 필요한 경우에 외에는 언급된 전망적 진술에 대해 어떠한 업데이트를 하거나 관련 진술에 대한 변경 결과를 공식적으로 발표할 의무를 지지 않는다. RFMD의 사업은 다음과 같이 많은 위험성과 불확실성을 가지고 있다: 분기별 사업운영 결과의 가변성, 무선 시장의 발전 및

성장 속도, 셀룰러 트랜스시버 및 GPS 솔루션을 포함한 무선 시스템 사업 철수 계획과 관련된 위험성, 본래 계획보다 구조조정 비용이 더 크고 구조조정으로부터 비용절감 및 기타 이득들이 달성되지 않을 위험성, 웨이퍼 제조시설 운영/분자빔 에피택시 시설/어셈블리조립 시설/테스트 및 테이프앤릴 시설과 관련된 위험요소, 인수 완료 및 인수 회사 통합 능력(사업 합병에 따른 시너지가 기대치에 미치지 못할 가능성 포함), 숙련된 인력 고용/유지 및 임원 계발 능력, 생산 수율의 가변성, 혁신적 기술 구현을 통한 비용 절감 및 총 수익 향상 능력, 신제품 출시 능력, 제품 수요 변화에 탄력적으로 대응하기 위한 적기의 생산량 조절 능력, 제한적인 고객 및 써드파티에 대한 의존도. 이러한 위험과 불확실성은 가장 최근에 美연방증권거래위원회에 제출된 RFMD의 10-K 애뉴얼 리포트에 자세히 기술되어 있다. 그러나 이는 전망에 불과하며, 실제로는 표시된 내용과는 전혀 다른 결과가 발생할 수도 있다.

RF MICRO DEVICES®와 RFMD®는 RFMD, LLC의 상표이다.
기타 모든 상호, 상표 및 등록상표는 해당소유자의 자산이다.